一种带辅助变压器的 Flyback

变换器 ZVS 软开关实现方案(图)

作者:陈世杰 吕征宇 钱照明

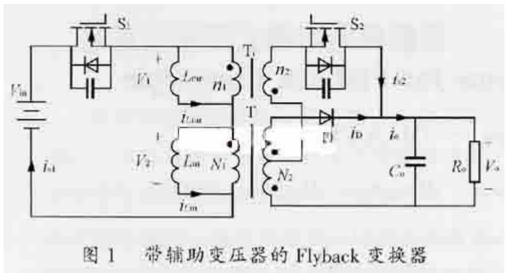
文章加入时间:2005年7月12日 16:00:58

摘要:提出了一种新颖的 FLYBACK 变换器 ZVS 软开关实现方案。一个较小的辅助变压器与主变压器串联,通过使辅助变压器原边激磁电感电流双向来达到主开关管的 ZVS 软开关条件。该方案实现了主辅开关管的 ZVS 软开关,限制了输出整流二极管关断时的 di/dt,并且使变换器在任何负载情况下,都能在宽输入范围内实现软开关。

关键词: ZVS 软开关;辅助变压器;电流双向

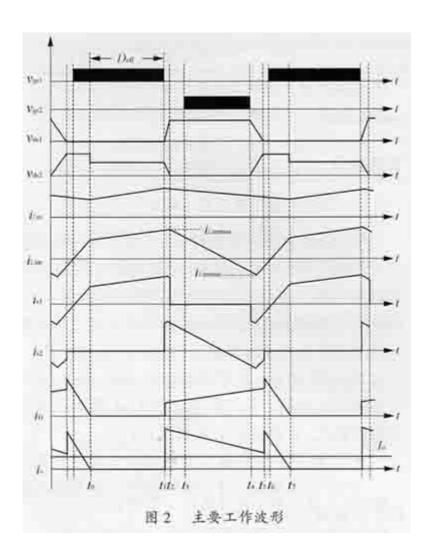
引言

在很多通讯和计算机系统中,需要使用高功率密度、高效率的开关电源。提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积,是目前开关电源提高功率密度的一种趋势。但是,开关频率的提高,开关器件的损耗也随之增加。



为了减小开关电源的开关损耗,提高其开关频率,软开关技术应运而生。软开关技术主要包括两种:零电压软开关(ZVS)及零电流软开关(ZCS)。在含有 MOSFET 开关器件的变换器拓扑中,零电压软开关要优于零电流软开关。

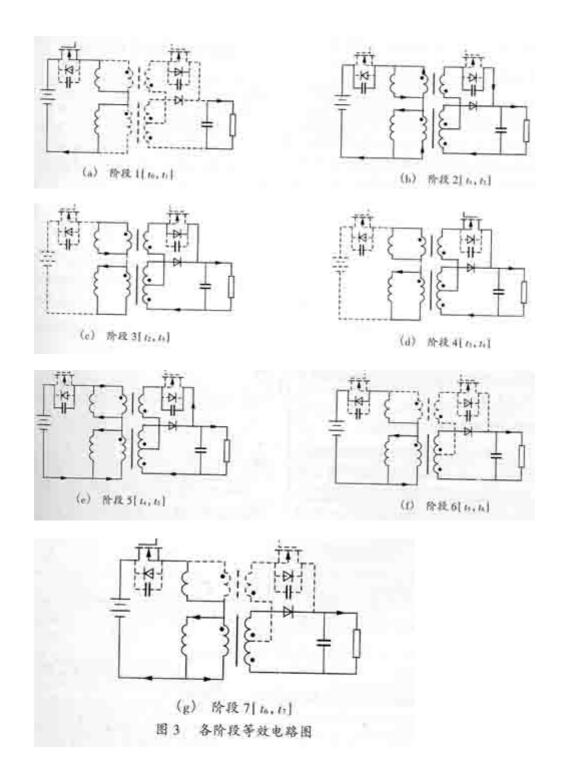
Flyback变换器电路简单,在小功率场合得到了广泛的应用。基于Flyback变换器的ZVS软开关拓扑也得到了进一步的发展[2][3][4]。最近几年,有源箝位ZVS软开关技术被提出[5][6][7],但它也



本文提出了一种带辅助变压器的Flyback零电压软开关电路,与有源箝位Flyback零电压软开关电路相比,它具有以下几个优点:

- 1) 电路在整个负载范围内都能实现软开关;
- 2)任何负载情况下,电路都可以在宽输入范围中实现软开关;
- 3) 丢失占空比不随输出负载变化而变化,利于电路参数设计。

下面分析了此电路的工作原理及软开关参数的设计,并以实验结果验证了该方案的有效性。



1 工作原理

图 1 为本文提出的 Flyback 软开关电路,Tr 为辅助变压器。其两个开关 S1 及 S2 互补导通,中间有一定的死区防止共态导通。主变压器 T 激磁电感 Lm 较大,使电路工作在电流连续模式(CCM),如图 2 中 iLm 波形所示。而 Tr 的激磁电感 Lmr 设计得较小(Lmr Lm),使流过 Lmr 的电流在一个周期内可以反向,如图 2 中 iLmr 波形所示。考虑到开关的结电容以及死区时间,一个周期可以分为 7 个阶段进行分析,各个阶段的等效电路如图 3 所示。其工作原理描述如下。1)阶段 1 [t0~t1] 该阶段,S1 导通,Lm 与 Lmr 串联承受输入电压,流过 Lm 及 Lmr 的电流

线性上升。此时间段

$$V_{ds2} = V_{in} \frac{L_{in} + L_{in}}{L_{in} + L_{in}} \frac{N_{i}}{N_{i}} \frac{L_{in} + L_{in}}{L_{in} + L_{in}} \frac{n_{2}}{n_{1}}$$
(1)

式中: Vds2 为 S2 的漏源电压;

Vo 为变换器输出电压;

N1 为 T 原边绕组匝数;

N2 及 N3 为 T 副边两个绕组匝数;

n1 及 n2 为 Tr 原副边两个绕组匝数。

2) 阶段 2 [$t1 \sim t2$] t1 时刻 S1 关断,Lm 上的电流通过 T 耦合到副边,使二极管 D 导通,Lm 两端电压被箝位在

$$V_2 = 21 \frac{N_1 V_2}{N_2 + N_3} \tag{2}$$

Lm 上的电流线性下降。

Lmr 上的电流一部分对 S1 的输出结电容 Cr1 充电 , 另一部分通过 Tr 耦合对 S2 的输出结电容 Cr2 放电。t2 时刻 , S2 的漏源电压下降到零 , 该阶段结束。

3) 阶段 3〔 $t2 \sim t3$ 〕当 S2 的漏源电压下降到零之后,S2 的寄生二极管导通,将 S2 的漏源电压箝位在零电压状态,也就为 S2 的零电压导通创造了条件。同时 Lmr 两端被箝位在

$$V_1 = -\frac{n_1}{n_2} \frac{N_3}{N_2 + N_3} V_o \tag{3}$$

Lmr 上电流线性下降。而 S1 的漏源电压被箝位在最大电压

$$V_{\text{delmax}} = V_{\text{in}} + \frac{n_1 N_2 N_2 + N_3 N_3}{n_2 (N_2 + N_3)} V_{\text{w}}$$
 (4)

4)阶段 4 [$t3 \sim t4$] t3 时刻 S2 的门极变为高电平,S2 零电压开通。流过寄生二极管的电流流经 S2。Lmr 两端依然承受式(3)所示电压 V1,Lmr 上电流线性下降到零然后反向增加。t4 时刻,S2 关断,该阶段结束。此时间段

$$i_{D} N_{3} + i_{o} N_{2} = i_{Lm} N_{1}$$
 (5)
$$i_{o} = i_{D} + i_{Lmr} \frac{n_{1}}{n_{2}}$$
 (6)
$$i_{D} = \frac{i_{Lm} N_{1} + i_{Lmr} \frac{n_{1}}{n_{2}} N_{2}}{N_{2} + N_{3}}$$
 (7)
$$i_{o} = \frac{i_{Lm} N_{1} + i_{Lmr} \frac{n_{1}}{n_{2}} N_{3}}{N_{2} + N_{3}}$$
 (8)

- 5) 阶段 5 [$t4 \sim t5$] t4 时刻,Lmr 上的电流方向为负,此电流一部分对 S1 的输出结电容 Cr1 放电,同时,另一部分通过 Tr 耦合到副边对 S2 的输出结电容 Cr2 充电。到 t5 时刻,S1 的漏源电压下降到零,该阶段结束。
- 6) 阶段 6 [$t5 \sim t6$] 当 S1 的漏源电压下降到零之后,S1 的寄生二极管导通,将 S1 的漏源电压箝位在零电压状态,为 S1 的零电压导通创造了条件。此时,Lmr 上的反向电流流经主变压器,给流过二极管 D 的电流 iD 叠加上一个电流

$$\Delta I_{(t5)} = \begin{vmatrix} i_{low}(t5) N_{tb} \\ N_2 + N_3 \end{vmatrix}$$
 (9)

此时间段内,二极管 D仍然导通,Lmr两端电压被箝位在

$$V_1 = V_{\rm in} - V_2 2 V_{\rm obs} \frac{N_1}{N_2 + N_3} V_{\rm o} \quad (10)$$

Lmr 上电流线性上升。而 S2 的漏源电压被箝位在最大电压

$$V_{\rm ds2max} = \left(V_{\rm in} + \frac{N}{N_2 + N_3} \frac{1}{N_2} \frac{n_{\rm part}}{n_1} \frac{N_3}{N_2 + N_3} V_{\rm o} \right)$$
(11)

7) 阶段 7 [$t6 \sim t7$] t6 时刻,S1 的门极变为高电平,S1 零电压开通。流过寄生二极管的电流流经 S1。由于 Lmr 两端承受的电压 V1 此时较大,iLmr 快速上升,到 t7 时刻,iLmr=iLm,主变压器耦合到副边的电流为零,二极管 D 自然关断。此时间段=

$$\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{n}}}{\mathrm{d}t} = -\frac{N_{\mathrm{1}}}{N_{\mathrm{2}} + N_{\mathrm{3}}} \left(\frac{V_{\mathrm{1}} + \frac{N_{\mathrm{1}}}{N_{\mathrm{2}} + N_{\mathrm{3}}} V_{\mathrm{o}}}{L_{\mathrm{mr}}} + \frac{\frac{N_{\mathrm{1}}}{N_{\mathrm{2}} + N_{\mathrm{3}}} V_{\mathrm{o}}}{L_{\mathrm{m}}} \right)$$

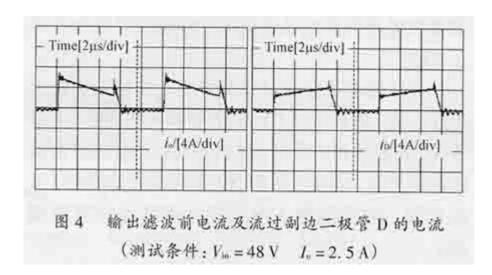
(12)由于Lmr Lm,式(12)可近似为

$$\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{D}}}{\mathrm{d}t} = -\frac{N_{1}}{N_{2} + N_{3}} \left(\frac{V_{1} + \frac{N_{1}}{N_{2} + N_{3}} V_{o}}{L_{\mathrm{m}}} \right)$$
(13)

接着 Lmr 与 Lm 串联承受输入电压,开始下一个周期。可以看到,在这种方案下,两个开关 S1 和 S2 零电压开通,二极管 D 零电流关断。

2 软开关的参数设计

假定电路工作在 CCM 状态。由于 S2 的软开关实现是 iLmrmax 对 Cr1 及 Cr2 充放电,而 S1 的软开关实现是 iLmrmin 对 Cr1 及 Cr2 充放电,在电路满载情况下,|iLmrmax|>>|iLmrmin|,而且 S2 的充电电压要大于放电电压(见图 2 波形 vds2),因此,S1 的软开关实现要比 S2 难得多。在参数设计中,关键是要考虑 S1 的软开关条件。



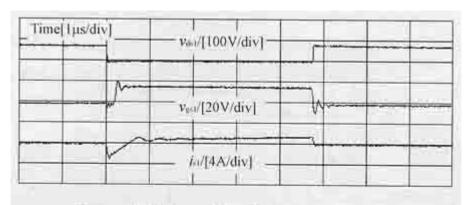


图 5 轻载时 S_1 的驱动电压、漏源电压及流过电流波形(测试条件: $V_{in} = 48 \text{ V}$ $I_{in} = 0.5 \text{ A}$)

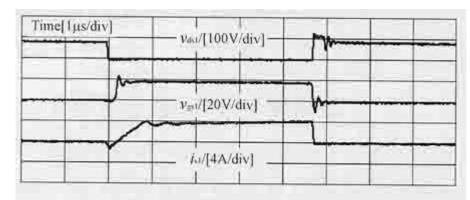


图 6 满载时 S₁ 的驱动电压、漏源电压及 流过电流波形(测试条件: V_m = 48 V I_o = 3.0 A)

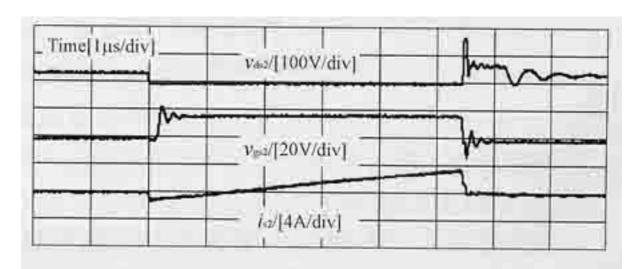


图 7 轻载时 S_2 的驱动电压、漏源电压及流过电流波形(测试条件: $V_m = 48 \text{ V}$ $I_a = 0.5 \text{ A}$)

2.1 主变压器激磁电感 Lm 的设定

由于 Lmr 的存在,变换器的有效占空比 Deff(根据激磁电感 Lm 的充放电时间定义,见图 2) 要小于 S1 的占空比 D,但是,由于 $t4\sim t7$ 时间内 iLmr 的上升速度非常快,所以,可近似认为 Deff=D。这样,根据 Flyback 电路工作在 CCM 的条件

$$L_{\rm m} \ge \frac{1}{2} \frac{\eta(V_{\rm in}D)^2}{P_{\rm o}^{\rm CM} f_{\rm s}} \quad (14)$$

式中:η为变换器效率;

fs 为开关频率;为变换器输出功率。

在实际设计中,为了保证电路在轻载时也能工作在电流连续模式,取定

$$\frac{N_1}{N_2 + N_3} = V_0 D \qquad (16)$$

2.2 主副变压器原副边匝数比设定

根据 Lmr Lm,及变换器输入输出关系有

而根据式(8),为了使输出滤波前电流 io 在 t3~t4 时间段下降不要太快,最好有 N3≤N2。

另外,为了保证 t1 时刻 S1 关断时流过副边二极管 D 的电流 iD>0,根据式 (7) 有



2.3 辅助变压器激磁电感 Lmr 设定

为了实现 S1 的 ZVS 软开关,在(1-D)T 时间内,激磁电感 Lmr 上电流必须反向,即

另外,根据Lmr与S1及S2的输出结电容谐振条件

$$\frac{1}{2}L_{\text{normin}}^{2} \ge \frac{1}{2}C_{\text{rl}}V_{\text{ds1mex}}^{2} + \frac{1}{2}C_{\text{r2}}V_{\text{ds2mex}}^{2} \qquad (21)$$

$$\frac{L_{\text{nor}} \ge \frac{-C_{\text{r}}V_{\text{ds1mex}}^{2}}{|i_{\text{directly light}}|^{2}} \qquad (22)$$

$$\frac{2}{C_{\text{r}}} = C_{\text{rl}} + C_{\text{r2}}\left(\frac{n_{2}}{n_{1}}\right)^{2} \qquad (23)$$

$$i_{\text{tmrmin}} = \frac{n_{1}N_{3}V_{u}}{n_{2}(N_{2} + N_{3})L_{\text{nor}}} (1 - D)T - i_{\text{Lummax}} \qquad (24)$$

将式(24)代入式(22)解得

$$L_{mr} \leq \frac{L_{mr} \leq \sqrt{C_{r}V_{ds1_{max}}^{2} + 4\frac{n_{1}N_{3}V_{o}}{n_{2} (N_{2} + N_{3}) f_{s}} (1 - D)i_{Lurmax}} - \sqrt{C_{r}}V_{ds1_{max}}}{2i_{Lurmax}}$$
(25)

比较式(20)和式(25),Lmr应该根据式(25)来设定。

另外,由式(24)可以发现,输入、输出电压一定时,随着负载的增加,iLmrmax 增大〔见式(19〕〕,iLmrmin 减小,软开关就越不容易实现。所以,Lmr 要根据满载时软开关的实现条件来设定。而当输入电压为宽范围时,随着输入电压的减小,iLmrmax 增加〔由于电路工作在 CCM,满载时式(19)第二项可以忽略〕,iLmrmin 表达式第一项减小,iLmrmin 减小,软开关就越不容易实现。所以,对于输出负载、输入电压变化的情况,Lmr 要根据输出满载、输入电压最小时

的软开关实现条件来设定。

同时需要指出,在能实现软开关的前提下,Lmr不宜太小,以免造成开关管上过大的电流应力及导通损耗。

2.4 死区时间的确定

为了实现 S1 的软开关,必须保证在 $t5\sim t6$ 时间内,S1 开始导通。否则,Lmr 上电流反向,重新对 Cr1 充电,这样,S1 的 ZVS 软开关条件就会丢失。因此,S2 关断后、S1 开通前的死区时间设定对开关管 S1 的软开关实现至关重要。合适的死区时间为电感 Lmr 与 S1 及 S2 的输出结电容谐振周期的 1/4,即

$$t_{\text{dead1}} = \frac{\pi}{2} \sqrt{L_{\text{mr}}^2 \left[C_{\text{rl}}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 C_{\text{r2}} \right]} \quad (26)$$

一般而言, 开关管输出电容是所受电压的函数, 为方便起见, 在此假设 Cr1 及 Cr2 恒定。

2.5 有效占空比 Deff 的计算

有效占空比 Deff 比 S1 的占空比 D 略小,即

根据
$$\Delta i_{low}(\Delta DT) \approx \Delta i_{low}(1-D) T - \Delta i_{low}(1-DT) \quad (28)$$
解得
$$\Delta D \approx \left\{ \frac{1}{V_{in}n_{2}(N_{2}+N_{3})} + \frac{N_{i}n_{2}}{n_{1}N_{3}} \times \frac{1}{L_{out}} \left[\frac{V_{in}(N_{2}+N_{3})}{V_{o}N_{1}} + 1 \right] \right\} \times (1-D) \quad (29)$$
代人式(27)得
$$D_{eff} = D - \left\{ \frac{1}{V_{in}n_{2}(N_{2}+N_{3})} + \frac{N_{i}n_{2}}{n_{1}N_{3}} \times \frac{1}{L_{out}} \left[\frac{V_{in}(N_{2}+N_{3})}{V_{o}N_{1}} + 1 \right] \right\} \times (1-D) \quad (30)$$

从式(29)可以看出,丢失占空比与输出负载无关。在相同电气规格和电路参数条件下,其值大概为有源箝位 Flyback 变换器满载时丢失占空比的 1/2[7]。

3 实验结果

为了验证上述的 ZVS 软开关实现方法,本文设计了一个实验电路,其规格及主要参数如下:

输入电压 Vin40~56V;

输出电压 Vo20V;

输出满载电流 Io3A;

工作频率 f100kHz;

S1及S2IRF640;

主变压器激磁电感 Lm222μH;

主变压器原副边匝数 N1: N2: N339: 15: 15;

辅助变压器激磁电感 Lmr10μH;

辅助变压器原副边匝数 n1:n213:13。

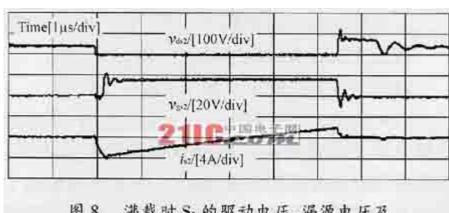
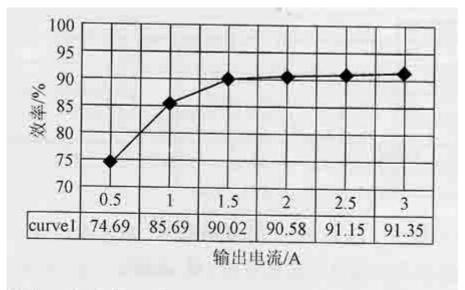


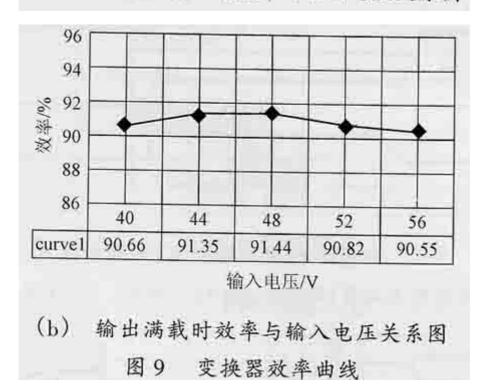
图 8 满载时 S₂ 的驱动电压、漏源电压及 流过电流波形(测试条件: V₁₀ = 48 V I₂ = 3.0 A)

图 4 给出的是负载电流 Io=2.5A 时,输出滤波前电流及流过副边二极管 D 电流的实验波形,其结果与理论分析相吻合。图 $5\sim$ 图 8 分别给出了 S1 和 S2 在轻载及满载时的驱动电压、漏源极电压和所流过电流的实验波形。从图中可以看出,当驱动电压为正时,开关管的漏源极电压已经为零,是零电压开通。而当开关管关断时,其结电容限制了漏源极电压的上升率,是零电压关断,由此说明 S1 及 S2 在轻载及满载时都实现了 ZVS[10]。从开关管漏源极电压与所流过电流的比较也可以看出实现了 ZVS。

图 9 给出了变换器效率曲线。图 9 (a) 为输入电压一定,负载电流不同时的变换效率曲线,可以看出,满载时效率最高,为 91.35%。图 9 (b) 为负载电流一定,输入电压不同时的变换效率曲线,可以看到,效率随输入电压变化而变化的范围很小。



(a) 额定输入电压时效率与输出电流关系图



4 结语

本文提出了一种 Flyback 变换器 ZVS 软开关拓扑,分析了其工作原理及其软开关参数的设计方法。由于软开关参数的设计(关键是辅助变压器原边激磁电感 Lmr 的设计)是根据满载及最小输入电压时的工作情况设计的,而随着负载的减轻和输入电压的增加,ZVS 软开关的实现也越容易。因此,该软开关拓扑可以工作在宽输入范围及任何负载范围,与有源箝位软开关拓扑相比具有一定的优点,可以作为应用于通讯、计算机系统等高功率密度场合的一种选择。